证券代码：688729 证券简称：屹唐股份 公告编号：2026-002

北京屹唐半导体科技股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度（以下简称“本年度”）募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

根据证监会于2025年3月11日出具的《关于同意北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕467号）以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票295,560,000股，每股发行价格为人民币8.45元，募集资金总额2,497,482,000.00元，扣除发行费用154,614,665.06元（不含增值税）后，募集资金净额为2,342,867,334.94元，以上募集资金于2025年7月3日到位，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了毕马威华振验字第2500465号验资报告。

2025年，公司已使用募集资金2,342,867,334.94元。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目2,342,867,334.94元，剩余募集资金余额730,052.31元。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年7月3日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	2,497,482,000.00
其中：超募资金金额	
减：发行费用	154,614,665.06
二、募集资金净额	2,342,867,334.94
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	2,342,867,334.94
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	144,189.01
其他-尚未支付的发行费用	585,863.30
二、报告期期末募集资金余额	730,052.31

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《北京屹唐半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等做出了明确的规定。为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开立的募集资金账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户开立及存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年7月3日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京屹唐半导体科技股份有限公司	兴业银行北京经济技术开发区支行	321130100100684767	45,561.32	使用中
北京屹唐半导体科技股份有限公司	中国工商银行北京经济技术开发区分行	0200316819100369546	627,539.35	使用中
北京屹唐半导体科技股份有限公司	招商银行北京亦庄支行	110920851710000	56,951.64	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年7月25日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,097,556,497.48元置换预先投入募集资金投资项目的2,042,867,334.94元及支付发行费用的54,689,162.54元自筹资金。议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议以及第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京屹唐半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2500465号）。本年度公司募投项目先期投入及置换情况见下表：

募集资金置换先期项目投入表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025年7月3日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目	642,867,334.94	642,867,334.94	642,867,334.94	2025年8月13日	2025年7月25日
屹唐半导体高端集成电路装备研发项目	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2025年8月13日	2025年7月25日
发展和科技储备资金	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	2025年8月13日	2025年7月25日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年7月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额，具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司募集资金投资项目不存在变更、对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2025年7月3日											
本年度投入募集资金总额	2,342,867,334.94											
已累计投入募集资金总额	2,342,867,334.94											
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目和超募资金投向	募集资金投向	项目性质	已更目（部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目是否发生重大变化
屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目	生产建设	不适用	否	800,000,000.00	642,867,334.94	642,867,334.94	642,867,334.94	642,867,334.94	-	100	2023年9月	不适用（注）	不适用	否
屹唐半导体高端集成电路装备研发项目	研发	不适用	否	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
发展和科技储备资金	研发	不适用	否	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计				2,500,000,000.00	2,342,867,334.94	2,342,867,334.94	2,342,867,334.94	2,342,867,334.94						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2025年7月25日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,097,556,497.48元置换预先投入募集资金投资项目的2,042,867,334.94元及支付发行费用的54,689,162.54元自筹资金。议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议以及第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京屹唐半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2504315号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于2025年7月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额并结合公司实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003）。

注：屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目主要为公司建设生产及研发设施及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理及生活服务设施及相应建筑物。于2025年度公司实现税后利润60,255.57万元。

证券代码：688729 证券简称：屹唐股份 公告编号：2026-009

北京屹唐半导体科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日 14点30分

召开地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号北京屹唐半导体科技股份有限公司208会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
4	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注：除上述议案外，本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688729	屹唐股份	2026/5/18

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记安排

拟现场出席本次会议的股东及股东代理人请于2026年5月20日之前将上述登记手续中所需的登记文件的扫描件发送至公司邮箱（ir@bestsemi.com）。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人的所有费用自理。

（二）本次股东会会期半天，请出席会议的股东及股东代理人携带登记文件原件，提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：阎美芝

电话：010-87842689

邮箱：ir@bestsemi.com

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京屹唐半导体科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案			
3	关于续聘2026年度审计机构的议案			
4	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：688729 公司简称：屹唐股份

北京屹唐半导体科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.273元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为2,955,560,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,686,788.00元（含税）。上述事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

二、公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	屹唐股份	688729	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单一	阎美芝
联系地址	北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号	北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号
电话	010-87842689	010-87842689
传真	010-67854899	010-67854899
电子信箱	ir@bestsemi.com	ir@bestsemi.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，面向全球集成电路制造厂商提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀及等离子体表面处理设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。

公司依靠自主研发的核心技术，致力于为集成电路制造环节提供更先进处理能力和更高生产效率的集成电路设备。公司主要设备相关技术达到国际领先水平，干法去胶设备、快速热处理设备已应用在多家国内外知名集成电路制造商生产线上并实现大规模装机，干法刻蚀及等离子体表面处理设备已应用在多家国内外知名集成电路制造商生产线上，销售收入持续快速增长。

2、主要产品

公司目前主要产品情况如下：

产品系列	图示	应用领域
干法去胶设备		
Suprema®系列干法去胶设备		主要用于集成电路芯片制造、芯片封装、微机电系统（MEMS）等领域，用于去除光刻后残余光刻胶，刻蚀后表面清洁、残留物清除、硬掩膜层干法清除等多种干法去胶和干法清除工艺。
Optima®系列干法去胶设备		主要用于集成电路芯片制造、芯片封装、微机电系统（MEMS）等领域，用于去除光刻后残余光刻胶，刻蚀后表面清洁、残留物清除、硬掩膜层干法清除等多种干法去胶和干法清除工艺。
Hydrilis® HMR高选择比先进光刻硬掩模材料去除设备		主要用于集成电路芯片制造中多种硬质掩模材料去除。
快速热处理设备		
Helios®系列快速热处理设备		广泛应用于逻辑芯片、3D NAND、DRAM、功率半导体、CMOS图像传感器等器件中快速热处理相关工艺，如离子注入激活和超浅结形成、源漏激活、掺氮修复，金属硅化物形成。
Millios®闪光毫秒级退火设备		主要应用于逻辑和存储器制造中用于超浅结形成，High k材料钝化和金属硅化物形成，也适用于其它材料的表面退火处理。
干法刻蚀及等离子体表面处理设备		
*paradigm*E®系列等离子体刻蚀设备		广泛应用于存储器和逻辑半导体制造中多晶硅、氧化硅、氮化硅刻蚀，侧墙刻蚀，金属硅化物阻挡层刻蚀，抗反射层刻蚀，自对准双重图形曝光刻蚀，钝化层刻蚀，刻蚀后表面处理，对准标记刻蚀等多种干法刻蚀工艺。
RENA-E®等离子体刻蚀设备		广泛应用于存储器、逻辑半导体、CMOS图像传感器制造中叠层（氮化硅，氧化硅）刻蚀、检塞回刻（PEB）、钝化层刻蚀、对准标记刻蚀、刻蚀后表面处理、引线孔刻蚀、金属-介质-金属复合钝化层刻蚀等多种干法刻蚀工艺。
Novyka®系列高选择比刻蚀和原子层级表面处理设备		广泛应用于存储器、逻辑半导体、功率IC制造中多种材料（多晶硅、氮化硅、氧化硅、金属钨或金属氮化物）的高选择比刻蚀工艺。
Hydrilis® XT 高产能等离子体干法刻蚀设备		半导体制造领域中准关键刻蚀的优选的等离子体干法刻蚀设备。
Escala®等离子体表面处理和材料改性设备		广泛应用于存储器和逻辑半导体制造中金属薄膜电阻率降低和金属回流裂缝修复，增强钨薄膜选择性沉积，增强可流动化学气相沉积介质薄膜致密度。

报告期内，公司的主营业务未发生变化。

2.2 主要经营模式

公司结合国家集成电路产业政策、市场发展和供需情况、半导体专用设备行业特点、公司主营业务、主要产品和自身发展阶段等因素，形成了目前的经营模式，经营模式与同行业惯例一致。具体如下：

1、盈利模式

公司主要从事集成电路设备的研发、生产和销售，通过向存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商、功率器件制造厂商等集成电路制造厂商和硅片制造厂商销售干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备，同时提供配件和服务来实现收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于集成电路设备产品的销售以及设备相关配件销售，提供设备升级维护服务等。

2、研发模式

公司依照行业国际惯例建立产品研发流程及相关制度，对研发项目的立项、审批、执行等流程进行了规定。公司的新产品研发及商业化流程可以大致分为可行性研究阶段、产品开发及下线阶段、客户端认证阶段，量产及生命周期维护阶段。

公司研发部门包含工程设计和工艺开发团队，分别负责干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备各个产品线包括机械设计、温控与仿真、电气设计、软件设计、工艺开发、新技术开发等各类开发内容。公司建立了科学、规范的研发工作制度，并以市场需求作为研发的导向，按照多种核心技术、多种产品进行新技术、新工艺、新产品的研发。通过对公司所有研发项目进行立项评审以及验收评审，保证公司研发目标的实现。

3、采购模式

为应对全球半导体供应链波动与地缘政治风险，公司建立了系统、科学的供应链评估与管理体系。不仅覆盖资质、产能、技术、质量、价格、交期、服务等基础要素，更强化了对关键零部件国产化能力及供应链抗风险指标的量化评估。公司已与全球众多供应商建立了长期稳定的合作关系，确保合格供应商的长期稳定性。同时从需求预测、库存管理、供应商管理三方面进行动态协调，以确保供应商稳定的前提下做到成本最优。中国制造基地近年积极推行供应链多元化与本地化战略，有效提高了设备零部件国产化率，缩短物流周期并降低采购成本，做到了供应链整体安全、可控。

4、生产模式

公司采用“客户订单驱动+战略库存驱动”的柔性生产模式，实现精准交付与快速响应的双重优势。客户订单驱动模式下，根据客户采购合同定制化生产，确保产品与需求高度匹配；战略库存驱动模式则针对通用型设备及组件进行前瞻性生产，有效缩短紧急订单交付周期，同时优化产能利用率。两种模式协同运作，既保障了订单交付质量，又提升了市场响应速度。通过对员工进行多技能培训，对生产场地进行升级改造，打造了柔性化生产线，从而具备快速调整不同产品产能的能力，以快速应对市场需求波动。

5、销售模式

公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。公司设备销售流程主要包括客户需求调研、技术交流、需求反馈与产品认证、销售洽谈与合同签订、发货、客户验收及售后服务等阶段。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、半导体设备市场规模高速增长

半导体产业作为现代信息技术产业的基石，是支撑数字经济、人工智能、新能源汽车等战略性新兴产业发展的核心基础，其技术水平和产业规模已成为衡量国家综合竞争力的关键指标。受益于人工智能相关应用的爆发式需求带动的高性能计算与数据中心基础设施的持续投资以及汽车电子、工业控制等新兴应用对半导体市场需求的多元化支撑，全球半导体市场规模高速增长，根据WSTS预测数据，2025年全球半导体市场规模预计将达到7,720亿美元，同比增长22.5%。展望2026年，全球半导体市场规模有望进一步增长至超过9,750亿美元，同比增长超过25%，首次逼近万亿美元大关。

半导体设备是集成电路制造的核心载体，其技术水平直接决定了芯片的制程能力、性能指标和生产良率。随着微观器件越做越小、结构越做越复杂，半导体设备的极端重要性更加凸显出来。半导体设备行业作为集成电路产业的基石，正处于市场规模增长与技术迭代加速的关键发展阶段。根据SEMI的统计数据，全球半导体设备市场（含前端晶圆制造及后端封测设备）在2025年达到创纪录的1,351亿美元，较2024年增长15.4%；SEMI预计2026年全球半导体设备市场规模将进一步扩大至1,450亿美元，同比增长7.3%。

2、半导体设备行业基本特点及主要技术门槛

半导体行业受国际经济波动、终端消费市场需求变化等方面影响，其发展往往呈现一定的周期性波动特征。在行业景气度较高时，半导体制造企业往往加大资本性支出，快速提升对半导体设备的需求；但在行业景气度下降过程中，半导体企业则可能削减资本支出，从而对半导体设备的需求产生不利影响。

半导体芯片应用领域极其广泛，既涵盖高性能计算、高端存储器等先进制程芯片需求，也包括电源管理、传感器、汽车电子、显示驱动、MCU、射频前端、功率器件、物联网芯片及工业控制等成熟制程芯片的庞大市场。尽管AI驱动下先进制程芯片需求呈爆发式增长，但并未挤压成熟制程芯片的生存空间，两者呈现并行发展态势。据集邦咨询（TrendForce）统计，2023年中国大陆28nm及以上成熟制程半导体制造产能占全球产能份额约29%，到2027年将进一步提升至33%，成为全球成熟制程半导体制造产能的主要贡献者。

半导体设备价值较高、技术复杂，半导体芯片制造商对于半导体设备的生产效率、良率提升、产品稳定性等方面具有很高的要求，对半导体供应商新设备的验证周期长、替代成本高，因此，半导体设备企业在客户验证、开拓市场方面周期较长，难度较大，产品成功导入客户量产线后客户稳定性也较高。

半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，半导体设备的研发涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、通讯、软件系统等众多学科领域，具有较高的技术研发门槛。在硬件、软件的支撑之外，半导体设备在客户端不同工艺制程产线上大量应用的过程中，设备厂商长久积累的实际应用经验（know-how）对于其进行产品改进和升级换代以及进一步的技术研发也非常重要，这种隐形的影响因素也进一步提升了半导体设备的研发门槛。随着高端逻辑芯片向2纳米及更先进制程迈进，先进存储器芯片向3D结构持续演进，先进封装技术等芯片技术的快速迭代，半导体设备面临着更高的技术挑战与技术创新需求。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在半导体设备领域，应用材料、泛林半导体、东京电子等国际龙头成立时间长，产品线布局相对完善，并在巩固自身优势基础上积极进行技术升级，占据了绝大部分市场份额。近年来，在中国大陆半导体制造投资浪潮推动下，国内半导体设备行业进入快速发展阶段。

1、干法去胶设备

在先进芯片制造工艺中，对底层材料的保护要求已达到原子级。干法去胶设备技术要求不断提高，干法去胶工艺逐渐成为先进光刻系列工艺中的一道关键步骤，设备应用也不断扩大。

公司的干法去胶设备在全球范围内的集成电路制造产线中具有广泛应用，设备工艺效果优异，具备颗粒污染低、连续生产时间长、大规模量产综合持有成本低等卓越性能，可满足各类制程工艺需求，尤其是在先进逻辑、先进存储及特色工艺芯片制造领域更具有竞争优势。

全球干法去胶设备领域的主要参与者包括PSK（比思科）、屹唐股份、ULVAC（爱发科）等。根据Gartner统计数据，2025年，干法去胶设备领域前五大厂商的市场份额合计超过90%，公司凭借33.7%的市场占有率位居全球第二，确立了在干法去胶设备细分市场中国际领先的行业地位，公司的去胶设备在国内市场亦占据领先地位。公司开发推出了新一代先进干法去胶设备Optima?，并持续开发新产品，进一步巩固公司在干法去胶设备领域的领先优势。

2、快速热处理设备

近年来，先进尖峰退火、激光/闪光毫秒退火在内的快速热处理技术越来越受到集成电路制造厂商的关注。随着集成电路线宽不断提高的要求，快速热退火技术在晶圆加工/集成电路制造中的竞争优势越来越明显；相比普通炉管退火设备几小时的加热时长，快速热退火设备只需几秒甚至几毫秒便可使晶圆上升至所需温度，总体热预算较低，可以更好地提高晶圆的性能，满足先进集成电路制造的需求。

公司的常压快速热处理设备采用晶圆双面辐射加热技术，具有温度均匀性好、有效减少晶圆热应力和图形效应、加热速度快、产出高等优势；毫秒级退火设备采用受专利保护的水壁氙气弧灯技术，具有优异的晶圆温度控制能力，独特的脉冲持续时间调整功能和一体式尖峰退火/闪光毫秒级退火功能相结合，提供了广泛的工艺应用。公司的常压快速热处理相关产品覆盖了国内外知名存储芯片、逻辑芯片、功率半导体、硅片制造厂商等领域广泛的客户。

应用材料在全球快速热处理设备领域占据绝对领先地位，根据Gartner统计数据，2025年，应用材料占有的全球快速热处理市场份额达到57.0%，公司占有的全球快速热处理市场份额为13.8%，在闪光退火设备领域市场份额位居全球第二。全球快速热处理市场的其他主要参与者包括维易科、科意半导体等。报告期内，公司借助在高温快速热处理、等离子体源及超高产出设备平台等领域的技术积累，持续开展多项新型快速热处理设备研发工作，尤其是加速推进低压快速热处理相关设备的研发，进一步扩大可服务市场规模。

3、干法刻蚀及等离子体表面处理设备

干法刻蚀设备是半导体制造中价值量最高的核心设备之一，技术壁垒极高，随着先进制程向2nm及以下演进及3D NAND堆叠层数持续增加，刻蚀工序数量大幅增加，对刻蚀设备的精度、选择比及产能效率提出了更高要求；先进制程和3D结构芯片制造中材料表面质量直接影响器件性能，等离子体表面处理设备通过远程等离子体源产生高浓度的自由基用于先进逻辑芯片、DRAM动态随机存取存储器、3D NAND闪存等工艺的选择性材料处理及改性等原子层级表面处理，应用场景持续扩大。

公司的刻蚀设备采用电感耦合等离子体（Inductively Coupled Plasma，简称ICP）技术实现离子能量与密度的独立控制，具备刻蚀速度快、产能高、使用成本低、等离子体损伤低等优势；高选择比刻蚀设备（可刻蚀多晶硅、钨、氮化钛等材料，根据应用气体和刻蚀材料的不同，选择比最高可达上百比一）、等离子体表面处理设备基于业界领先的远程等离子体与离子辅助控制技术，可满足先进芯片制造中多道尖端刻蚀和原子层级晶圆表面处理要求。公司的干法刻蚀设备和等离子体表面处理相关设备已应用于国内外知名存储芯片和逻辑芯片制造企业客户，销售收入持续快速增长。

全球干法刻蚀设备市场主要由国际巨头主导，根据Gartner统计数据，2025年，前三大厂商泛林半导体、东京电子及应用材料合计占有全球干法刻蚀设备领域82.2%的市场份额，市场格局高度集中。公司是国内为数不多可以量产干法刻蚀设备的厂商，根据Gartner统计数据，2025年公司以0.5%的市场占有率位居全球第九。报告期内，公司推出了新一代先进干法刻蚀设备RENA-E?，先进等离子体表面处理和材料改性设备Escala?，并持续开展多项新型干法刻蚀及等离子体表面处理设备研发工作，进一步扩大可服务市场规模。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，全球半导体制造产业在人工智能、高性能计算